

<<硅锆的性质>>

图书基本信息

书名：<<硅锆的性质>>

13位ISBN编号：9787118028836

10位ISBN编号：7118028835

出版时间：2002-9

出版时间：国防工业出版社

作者：卡斯珀

译者：余金中

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<硅锗的性质>>

内容概要

《硅锗的性质》由31位来自德国、美国、加拿大、英国、日本等国Si基异质结构和应用领域的教授们撰稿，是一本论述SiGe / Si知识的权威性专著。

《硅锗的性质》共七章，第一章综述了SiGe应变层系统的一些总体性质；第二章至第六章给出了应变的和弛豫的SiGe合金的具体材料性质，论述了SiGe材料的结晶学、异质结构、热学性质、力学和晶格振动、能带结构、输运特性、磁学特性、表面性质、光吸收和光谱等方面的内容；第七章介绍了一些代表性的SiGe / Si器件的结构和特性。

《硅锗的性质》是半导体领域的学者和工程技术人员的必读书，适于材料专业和半导体专业的科技人员、研究生、博士生阅读，还可供物理领域中的广大科技人员作为手册进行查阅。

继Si之后，SiGe / Si是研究得最多、最深入的一类Si基异质材料。

应变的和弛豫的SiGe已经成为电子集成电路和光电子集成电路的非常重要的材料。

<<硅锗的性质>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>